

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

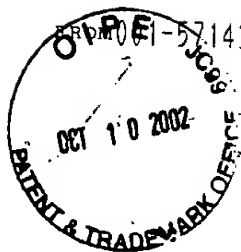
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



P. 01-5714342916=RIPL0

/081-462702408=

/10-2=-10-03:00Y001-002 4801352444 P 2

- (19) Japan Patent Office
- (12) Publication of Patent Application (A)
- (11) Japanese Patent Laid-Open No. 74763/1993
- (43) Laid-Open Date: March 26, 1993
- (51) International Patent Classification Identification number Intraoffice Reference Number
- | | | |
|-------------|---|---------|
| H01L 21/316 | X | 8518-4M |
| C23C 16/50 | | 7325-4K |
| H01L 29/784 | | 9056-4M |

FI

H01L 29/78 311 G

Request for Examination: Not made

Number of Claims 3 OL (4 pages in total)

(21) Application No. 179994/1991

(22) Application Date: July 19, 1991

(71) Applicant:

390028004

GTC Corporation.

6-5, Higashi-Nihombashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo

(72) Inventor:

Hideo Izawa

c/o GTC Corporation.

6-5, Higashi-Nihombashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo

(72) Inventor:

Kiyoshi Toda

c/o GTC Corporation.

6-5, Higashi-Nihombashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo

(72) Inventor:

Mitsuo Ishii

c/o GTC Corporation.

6-5, Higashi-Nihombashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo

(74) Agent

[Patent Attorney] Masatake Shiga (Others 2)

[Title of the invention] Methods for forming gate insulating films

[Abstract]

[Objective] To provide a method for forming a gate insulating film having an excellent step coverage performance which is capable of being treated at a low temperature.

[Aspect] An organic silane material is employed as a reactive gas to form a gate insulating film by a plasma CVD method.

[Claims]

[Claim 1] A method for forming a gate insulating film comprising using an organic silane material is employed as a reactive gas and forming a film by a plasma CVD method.

[Claim 2] A method for forming a gate insulating film according to Claim 1 wherein said plasma CVD method employs a

CVD device of a parallel plate electrode type and the film is formed under a condition which allows the product $P \cdot d$ of the gas pressure P (Torr) and the distance d (cm) between the substrate electrodes to be 5 or more.

[Claim 3] A method for forming a gate insulating film according to Claim 2 wherein the gate insulating film is formed by the plasma CVD method and then annealed in an inert gas atmosphere.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Field of Application]

The present invention relates to a method for forming a gate insulating film, more particularly to a method which is extremely useful in forming a gate insulating film for a thin film transistor.

[0002]

[Prior Art]

Usually in forming a gate insulating film such as a thin film transistor on a low melting point substrate such as a glass, an SiO_2 as a gate insulating film is formed mainly by a plasma CVD (chemical vapor deposition) method employing SiH_4 or an atmospheric pressure CVD method, since a heat oxidation method accompanied with a gas phase reaction at a high temperature can not be employed. Such a conventional method for forming a gate insulating film employing such a plasma CVD method is frequently

a method employing SiH_4 , and such a method exhibits a poor step coverage performance at a position having steps such as a wiring position. Thus, when a gate insulating film 3 is formed on a semiconductor layer 2 of a certain pattern formed on a substrate 1 as shown in Figure 2, a step part 3a of the gate insulating film 3 is in a overhanging shape, reducing the thickness of the film under the step. As a result, a gate electrode 4, when formed on the gate insulating film 3, readily undergoes dielectric breakdown at the part where the gate insulating film 3 is too thin, sometimes resulting in an accidental short circuit between the gate electrode 4 and the semiconductor layer 2. The gate electrode 4 also readily undergoes the breaking, which is one of the causes of a low yield.

[0003]

[Problems that the Invention is to Solve]

A solution to be given by the present invention is to provide a method for forming at a low temperature a gate insulating film which exhibits an excellent step coverage performance and reduces the risk of the short circuit between a gate electrode and a semiconductor layer and the breaking of the gate electrode.

[0004]

[Means for Solving the Problems]

For the purpose of solving the problems described above, the invention employs as a reactive gas an organic silane material to form a gate insulating film by a plasma CVD method. Such

a plasma CVD method is preferably conducted using a CVD device of a parallel plate electrode type under a condition which allows the product $P \cdot d$ of the gas pressure P (Torr) and the distance d (cm) between the substrate electrodes to be 5 or more. It is also possible that a gate insulating film is formed by a plasma CVD method and subsequently annealed in the atmosphere of an inert gas, such as nitrogen, whereby obtaining a gate insulating film whose characteristics are further excellent.

[0005]

A method for forming a gate insulating film of the invention can be employed not only for a gate insulating film of a thin film transistor but also for a gate insulating film for any of various gate insulating films such as one for an ordinary MIS transistor. Such a gate insulating film can be formed from insulating materials such as SiO_2 , Si_3N_4 and the like. An organic silane material mentioned above may for example be TEOS (tetraethyl orthosilicate), 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, diethylsilane, 3-ethoxysilane, 2-ethylsilane, 4-methylcyclotetrasiloxane and the like. The pressure P of a gas for forming a gate insulating film for example of SiO_2 by a plasma CVD method is preferably 0.1 to 6 Torr. When TEOS is employed as an organic silane material, TEOS is mixed with oxygen preferably in the ratio of oxygen/TEOS=5 to 30. The annealing is conducted in the atmosphere of an inert gas such as nitrogen or argon gas or of a mixture thereof with

an appropriate amount of oxygen. While the temperature and the time period of such a process may vary depending on the types of the substrate employed and the insulating film to be formed, they are preferably 500 to 600°C and 30 minutes to 4 hours, respectively, when an SiO_2 insulating film for a thin film transistor is formed on a glass. When forming an Si_3N_4 , an oxygen-free organic silane material is employed together with an inert gas such as N_2 or He as a bubbling carrier gas using NH_3 and N_2H_4 instead of introducing oxygen in a manner similar for forming an SiO_2 insulating film.

[0006]

While an SiO_2 insulating film formed using an organic silane material by a plasma CVD method has been utilized as a inter-layer insulating film for example of an LSI, such a film has an extremely rough quality since the plasma CVD has been employed in a range where the film forming speed is high. We made every effort and established the invention based on the discovery that when using a CDV device of a parallel plate electrode type the product $P \cdot d$ of the film forming gas pressure P (Torr) and the distance d (cm) between the substrate electrodes is in a certain correlation with the film forming speed or the etching rate using a buffered hydrofluoric acid (BHF) as shown in Figure 4. In this figure, the etching rate represents the density of the SiO_2 oxidation film, and a lower rate reflects a more dense and satisfactory film. Based on this figure, the etching rate becomes 2000

angstrom/minutes at a P·d of 5 or more, which enables the formation of a gate insulating film whose density is higher than that of a conventional SiH₄-derived SiO₂ insulating film.

[0007]

[Effect]

A substrate in which a certain pattern semiconductor layer has been formed is mounted on a sample platform in a plasma CVD device chamber, and after imparting the chamber with a high vacuum a reactive gas containing an organic silane gas is introduced at a certain flow rate. At the same time, a plasma is generated near the substrate by a high frequency power or other means. As a result, the reactive gas around the substrate is activated by the plasma, undergoes a chemical reaction to form a gate insulating film for example of an SiO₂ film on the substrate. Since this film forming reaction is on the basis of the activation of the reactive gas by the plasma, the film can be formed at a low temperature. Also by using a CVD device of a parallel plate electrode type to adjust the product P·d of the reactive gas pressure P and the distance d (cm) between the cathode electrode and the substrate 1 at 5 or more, the resultant gate insulating film becomes extremely dense and the step coverage is also improved. In addition, an annealing in an inert gas such as nitrogen after forming the gate insulating film results in a reduction in the leak current of this gate insulating film, whereby improving the electric characteristics.

[0008]

[Examples]

The invention is further described in the following Examples to clarify the advantageous effects of the invention. As shown in Figure 1, a substrate 1 in which a certain pattern semiconductor layer 2 has been formed was mounted on a sample platform 14 as an anode of the parallel plate electrodes provided in a plasma CVD device chamber 13, and the air in the chamber 13 was exhausted via a vacuum exhaust outlet 19 to impart a high vacuum. Subsequently, an organic silane material TEOS in a vaporization device 12 was adjusted at 20°C and oxygen is pumped via a bubbling carrier gas inlet 11 at 40 sccm (standard cc/min) to effect the bubbling and to vaporize the TEOS while introducing oxygen via an oxygen inlet 10 at 50 sccm, which was mixed with the previously vaporized TEOS using a reactive gas mixer 18 and then introduced into the chamber 13. Thereafter, a high frequency power 17 was employed to apply a high frequency voltage between a cathode 16 of the parallel plate electrodes and the sample platform 14, whereby generating a plasma between the parallel plate electrodes. This process gave the RF power of 0.3 W/cm² at 13.56 Hz, the reactive gas pressure in the chamber 13 of 0.8 Torr and the distance d between the cathode 16 and the substrate 1 of 7.5 cm, resulting in the p·d product of 6. The temperature of the substrate 1 was kept almost at 350°C. As a result, the interaction between the plasma and the reactive

gas allowed an SiO_2 oxidation film to be formed on the substrate

1.

[0009]

In order to introduce the TEOS gas into the chamber 13, a method which does not employ the bubbling described above can also be used. For example, the temperature in the vaporizing device 12 containing the TEOS is raised to elevate the vapor pressure of the TEOS, and this TEOS gas can be controlled directly by a mass flow controller to introduce into the chamber. This mass flow controller-employing method enables a more precise control of the amount of an organic silane material such as TEOS to be introduced, which leads to the formation of a more excellent insulating film.

[0010]

Figure 3 shows a partial sectional view of a thin film transistor reflecting the film forming condition of an SiO_2 oxidation film 3 formed on a substrate 1 and a semiconductor layer 2 under the condition described above covered with an Al gate electrode film 4 further formed thereon by sputtering method. As evident from this figure, an extremely dense SiO_2 film 3 was deposited uniformly in a sufficient amount even on the wall of the step of a semiconductor layer 2, whereby avoiding any overhanging which was experienced in a conventional method.

[0011]

The interfacial order density and the leak current of the

gate insulating film thus formed were characterized electrically. The gate insulating film was also annealed in nitrogen at 600°C for 2 hours, and its interfacial order density and the leak current were also characterized electrically. The results are shown in Table 1.

[0012]

[Table 1]

	As Depc	Annealing in N ₂ , 600°C, 2 hr
Interfacial order dencity (cm ⁻² eV ⁻¹)	8.1×10^{10}	6.4×10^{10}
Leak current (A/cm ²)	5.9×10^{-10}	5.0×10^{-11}

[0013]

As evident from these results, a gate insulating film formed as described above has satisfactory electric characteristics, and by annealing such a gate insulating film in nitrogen the leak current can be reduced by 1 order or more, whereby further improving the electric characteristics. The resultant film is sufficient characteristically as a gate insulating film of a thin film transistor and MIS transistor. The leak current in Table 1 was measured with applying the electric field of 2 MV/cm. Furthermore, gate insulating films were formed by the plasma CVD method under the condition similar to the example described above except for varying the reactive gas pressure P in the chamber and the distance d between the cathode electrode and the substrate 1 whereby varying the P·d product from 1 to

8. Each gate insulating film was examined for the step coverage performance and the electric characteristics, and then subjected to the annealing in nitrogen similarly to the example described above to examine the electric characteristics. As a result, a gate insulating film having an excellent step coverage performance was obtained when the film forming was effected at a P·d product of 5 or more. In addition, the gate insulating film formed at a P·d product of 5 or more has satisfactory electric characteristics, which were proven to be further improved when this gate insulating film was annealed in an inert gas such as nitrogen.

[0014]

[Effects of the invention]

As detailed above, a method for forming a gate insulating film according to the invention which employs as a reactive gas an organic silane material and forms a film by a plasma CVD method enables a low temperature formation of a gate insulating film having an excellent step coverage performance and capable of reducing the risk of the short circuit between a gate electrode and a semiconductor layer and the breaking of the gate electrode. Accordingly, it is useful especially for forming a gate insulating film of a thin film transistor employing a substrate whose melting point is low.

[Brief Description of the Drawings]

[Figure 1]

A sectional view of a plasma CVD device employed in a method for forming a gate insulating film according to the invention.

[Figure 2]

A partial sectional view of a thin film transistor reflecting the film forming condition of a gate insulating film formed by a conventional method.

[Figure 3]

A partial sectional view of a thin film transistor reflecting the film forming condition of a gate insulating film formed by a method of the invention.

[Figure 4]

A graph representing the correlation of the film forming condition P·d product with the film forming speed and the etching rate.

[Description of the Reference Numerals and Signs]

1: Substrate, 2: Semiconductor layer, 3: Gate insulating film, 4: Gate electrode, 10: Oxygen inlet, 11: Bubbling carrier gas inlet, 12: Vaporization device, 13: Plasma CVD device chamber, 14: Sample platform, 16: Cathode, 17: High frequency power, 18: Reactive gas mixer, 19: Vacuum exhaust outlet

Figure 4

FILM FORMING SPEED (Å/min)

ETCHING RATE (Å/min)

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

11087934

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 5074763 A2 930326 <No. of Patents: 001>

FORMATION OF GATE INSULATING FILM (English)

Patent Assignee: GTC KK

Author (Inventor): IZAWA HIDEO; TODA KIYOSHI; ISHII MITSUO

IPC: *H01L-021/316; C23C-016/50; H01L-029/784

CA Abstract No: 119(26)284282S

Derwent WPI Acc No: C 93-138193

JAPIO Reference No: 170398E000103

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
-----------	------	------	-----------	------	------

JP 5074763	A2	930326	JP 91179994	A	910719 (BASIC)
-------------------	----	--------	-------------	---	----------------

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 91179994 A 910719

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04083063 **Image available**

FORMATION OF GATE INSULATING FILM

PUB. NO.: 05-074763 [JP 5074763 A]

PUBLISHED: March 26, 1993 (19930326)

INVENTOR(s): IZAWA HIDEO

TODA KIYOSHI

ISHII MITSUO

APPLICANT(s): G T C KK [000000] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)

APPL. NO.: 03-179994 [JP 91179994]

FILED: July 19, 1991 (19910719)

INTL CLASS: [5] H01L-021/316; C23C-016/50; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 12.6 (METALS --
Surface Treatment)

JAPIO KEYWORD: R004 (PLASMA); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide
Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1403, Vol. 17, No. 398, Pg. 103, July
26, 1993 (19930726)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable an insulating film which is excellent in level difference coverage, prevents a short circuit from being induced between a gate electrode and a semiconductor layer, and hardly insulates a gate electrode thermally to be formed at a low temperature by a method wherein organic silane is used as reactive gas to form the insulating film through a CVD method.

CONSTITUTION: A substrate 1 where a semiconductor layer 2 is formed is set on a parallel plate type anode electrode specimen table 14 located inside a plasma CVD device chamber 13, and air is exhausted from the chamber 13 through an evacuation, opening. Thereafter, organic silane inside the evaporator 12 is bubbled introducing oxygen into a bubbling carrier gas inlet, oxygen is introduced through an oxygen introducing 10, the silane gas and hydrogen gas are mixed together through a reactive gas mixer 18, and the mixed gas of silane gas and hydrogen gas are introduced into the chamber 13. A high frequency voltage is applied between a parallel plate type cathode electrode and the specimen table 14 by a high frequency power supply 17 to generate plasma between the parallel plate type electrodes. By this setup, a gate insulating film excellent in level difference coverage can be formed.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-74763

(43)公開日 平成5年(1993)3月26日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/316	X	8518-4M		
C 2 3 C 16/50		7325-4K		
H 0 1 L 29/784		9056-4M	H 0 1 L 29/ 78	3 1 1 G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号 特願平3-179994

(22)出願日 平成3年(1991)7月19日

(71)出願人 390028004

株式会社ジーティシー

東京都中央区東日本橋1丁目6番5号

(72)発明者 井澤 秀雄

東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会
社ジーティシー内

(72)発明者 戸田 清

東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会
社ジーティシー内

(72)発明者 石井 三男

東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会
社ジーティシー内

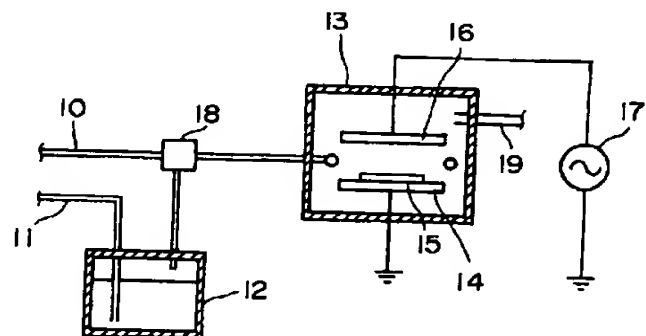
(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外2名)

(54)【発明の名称】 ゲート絶縁膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 段差部分の被覆性に優れ、低温処理可能なゲート絶縁膜形成方法を提供する。

【構成】 反応ガスとして有機シラン材料を用い、プラズマCVD法によりゲート絶縁膜を成膜する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応ガスとして有機シラン材料を用い、プラズマCVD法により成膜することを特徴とするゲート絶縁膜の形成方法。

【請求項2】 前記プラズマCVD法は、平行平板電極型のCVD装置を用いるものであり、かつ、ガス圧力P (Torr)と基板電極間距離d (cm)との積 $P \cdot d$ が5以上となる条件で成膜する請求項1記載のゲート絶縁膜の形成方法。

【請求項3】 ゲート絶縁膜をプラズマCVD法により成膜した後、不活性ガス雰囲気中でアニールする請求項2記載のゲート絶縁膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、ゲート絶縁膜の形成方法に関し、ことに、薄膜トランジスタのゲート絶縁膜の形成にきわめて有用な方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】一般に、ガラスなどの低融点基板上に薄膜トランジスタなどのゲート絶縁膜を形成する場合、高温での気相反応を伴う熱酸化法を用いることができないため、主に、 SiH_4 を用いたプラズマCVD (Chemical Vapor Deposition)法あるいは常圧CVD法などを用いてゲート絶縁膜となる SiO_2 を形成している。このように、従来のプラズマCVD法などによるゲート絶縁膜形成方法は主に SiH_4 を用いるものであり、この方法によると、配線などの段差部分の被覆性 (ステップカバレッジ)に問題が生じる。すなわち、図2に示すように、このような方法によって、基板1上に形成された所定パターンの半導体層2の上にゲート絶縁膜3を形成すると、このゲート絶縁膜3の段差部分3aはオーバーハング形状となり、段差下部の膜厚が薄くなってしまう。その結果、ゲート絶縁膜3の上にゲート電極4を形成した場合、このゲート絶縁膜3の膜厚の薄い部分での絶縁破壊が起こり易く、しばしばゲート電極4と半導体層2間がショートしてしまう事故が起こっていた。また、ゲート電極4の断線も起こり易く、これも歩留り低下の一因となっていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】この発明が解決しようとする課題は、段差部分の被覆性に優れ、ゲート電極と半導体層間のショートおよびゲート電極の断線が起きにくいゲート絶縁膜を低温で形成することのできる方法を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】この発明は、上記課題を解決するため、反応ガスとして有機シラン材料を用い、プラズマCVD法によりゲート絶縁膜を成膜するものである。また、前記プラズマCVD法としては、平行平板電極型のCVD装置を用い、かつ、ガス圧力P (Torr)

r)と基板電極間距離d (cm)との積 $P \cdot d$ が5以上となる条件で成膜するのが好ましい。さらに、ゲート絶縁膜をプラズマCVD法により成膜した後、窒素などの不活性ガス雰囲気中でアニールすることによって、より特性の優れたゲート絶縁膜を得ることができる。

【0005】この発明のゲート絶縁膜形成方法は、薄膜トランジスタのゲート絶縁膜だけでなく、MISトランジスタ一般のゲート絶縁膜など、あらゆる種類のゲート絶縁膜の形成に用いることができる。また、ゲート絶縁膜としては、 SiO_2 、 Si_3N_4 などの絶縁材料により成膜することも可能である。上記有機シラン材料としては、TEOS (テトラエチルオルトシリケート)、2, 4, 6, 8-テトラメチルシクロテトラシロキサン)、ジエチルシラン、3エトキシシラン、2エチルシラン、4メチルシクロテトラシロキサンなど、各種有機シラン材料を用いることができる。プラズマCVD法により SiO_2 などのゲート絶縁膜を形成するためのガス圧力Pは、通常、0.1~6 Torrが好ましい。また、有機シラン材料としてTEOSを用いたときの酸素とTEOSとのガス混合比は、酸素/TEOS=5~30であることが好ましい。また、アニールは、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性ガス、あるいはこれに酸素を適量混合した雰囲気中で行われる。この場合の処理温度および処理時間は、用いる基板および形成する絶縁膜の種類によって異なるが、ガラス上に薄膜トランジスタ用 SiO_2 絶縁膜を形成する場合には、500~600°C、30分~4時間の範囲内で行うことが好ましい。また、 Si_3N_4 を形成する場合には、酸素を含まない有機シラン材料を用い、パブリック用キャリアガスとして N_2 あるいはHeなどの不活性ガスを、また、導入酸素の代わりに NH_3 、 N_2H_4 などを用いて SiO_2 絶縁膜形成の場合と同様に行なえばよい。

【0006】プラズマCVD法により有機シラン材料を用いて形成した SiO_2 絶縁膜は、従来、LSIなどの層間絶縁膜として利用されてはきたが、この場合、プラズマCVDは成膜速度の大きな領域で用いられており、生成される膜質はきわめて粗いものであった。この発明は、本発明者等が多くの実験と研究を重ねた結果、図4に示すように、平行平板電極型のCVD装置を用いる場合、成膜ガス圧力P (Torr)と基板電極間距離d (cm)との積 $P \cdot d$ と成膜速度および緩衝フッ酸 (BHF)などに対するエッチングレートとの間に一定の関係があることを見出したことに基づいてなされたものである。この図において、エッチングレートは SiO_2 酸化膜の緻密性を示しており、小さければ小さいほど緻密で良質な膜であると考えられる。この図によれば、 $P \cdot d$ が5以上の領域でエッチングレートが2000オングストローム/分となり、従来用いられてきた SiH_4 による SiO_2 絶縁膜以上の緻密なゲート絶縁膜を形成することができる。

【0007】

【作用】プラズマCVD装置チャンバ内の試料台上に所定パターンの半導体層を形成した基板がセットされ、チャンバ内部が高真空とされた後、所定流量の有機シランガスを含む反応ガスが導入される。同時に、高周波電源その他の手段によって基板近傍にプラズマを発生させる。すると、基板近傍の反応ガスはプラズマによって活性化され、化学反応を起こし、基板上にSiO₂膜などのゲート絶縁膜が生成されることになる。この生成反応はプラズマによって反応ガスを活性化するものであるため、低い温度での成膜が可能となる。また、平行平板電極型のCVD装置を用い、チャンバ内部の反応ガス圧Pと、カソード電極と基板1間の距離dとの積P・dを5以上とすれば、生成されるゲート絶縁膜はきわめて緻密なものとなり、ステップカバレッジも向上する。さらに、ゲート絶縁膜を形成後、窒素などの不活性ガス中でアニールすれば、このゲート絶縁膜のリーク電流は減少し、電気特性が向上する。

【0008】

【実施例】以下、実施例を示してこの発明の作用、効果を明確にする。図1に示すように、プラズマCVD装置チャンバ13内に設けられた平行平板型電極のアノードを構成する試料台14上に、所定パターンの半導体層2が形成された基板1をセットし、チャンバ13内部の空気を真空排気口19から排出して高真空とした。その後、気化器12内の有機シラン材料TEOSを20℃にして、バブリング用キャリアガス導入口11から酸素を40sccm (Standard cc/min) 流してバブリングを行い、TEOSを気化させると同時に、酸素導入口10から酸素を50sccm導入し、反応ガス混合器18によりこの酸素と前記気化させたTEOSガスとを混合して、チャンバ13内に導入した。そして、高周波電源17により平行平板型電極のカソード16と試料台14と

の間に高周波電圧を印加し、平行平板型電極間にプラズマを発生させた。このときのRFパワーは13.56Hzで0.3W/cm²であり、また、チャンバ13内の反応ガス圧は0.8 Torr、カソード電極16と基板1間の距離dは7.5cmであり、このため、P・d積は6であった。基板1の温度はほぼ350℃に保たれた。その結果、プラズマと反応ガスとの相互作用によって、基板1上にSiO₂酸化膜が形成された。

【0009】チャンバ13内にTEOSガスを導入するには、上記のようなバブリングによらない方法もある。たとえば、TEOSが入っている気化器12内の温度を上昇させてTEOSの蒸気圧を上昇させ、このTEOSガスをマスフローコントローラにより直接制御してチャンバ内に導入することもできる。このマスフローコントローラによる方法によれば、TEOSなどの有機シラン材料導入量をより精確に制御することができ、より優れた絶縁膜の形成が可能となる。

【0010】図3は、上記の条件で、基板1および半導体層2上にSiO₂酸化膜3を形成し、その後、この上にA1のゲート電極膜4をスパッタ法により形成した場合の成膜状態を示す薄膜トランジスタの部分断面図である。この図から明らかなように、半導体層2の段差部分の壁面にもきわめて緻密なSiO₂膜3が均一に充分堆積しており、従来の方法による場合に発生するオーバーハングが全く発生していないことが分かる。

【0011】次に、このようにして形成したゲート絶縁膜の界面単位密度およびリーク電流について電気特性を調べた。また、このゲート絶縁膜を窒素中で600℃、2時間のアニールを行ない、その界面単位密度およびリーク電流についても電気特性を調べた。これらの結果を表1に示す。

【0012】

【表1】

	As Depo	窒素中700-800℃、2hr
界面単位密度 (cm ⁻² eV ⁻¹)	8.1×10 ¹⁰	6.4×10 ¹⁰
リーク電流 (A/cm ²)	5.9×10 ⁻¹⁰	5.0×10 ⁻¹¹

【0013】これらの結果から明らかなように、上記のようにして形成したゲート絶縁膜は、良好な電気特性を有しており、また、このゲート絶縁膜を窒素中でアニールすることによってリーク電流を1桁以上減少させることができ、その電気特性をさらに向上させることができる。これは、薄膜トランジスタ、MISトランジスタなどのゲート絶縁膜として十分な特性を持つものである。

なお、表1におけるリーク電流は、2MV/cmの電界を加えて測定されたものである。また、チャンバ内の反応ガス圧Pおよびカソード電極と基板1間の距離dを種々変えてP・d積を1～8まで変化させるとともに、他の条件については前記の実施例と同様にして、プラズマCVD法によりゲート絶縁膜をそれぞれ形成した。これらのゲート絶縁膜の段差被覆性、電気特性を調べ、ま

た、このゲート絶縁膜を窒素中で前記実施例と同様のアニールを行ない、その電気特性についても調べた。その結果、 $P \cdot d$ 積が5以上の領域で成膜したときに段差被覆性の優れたゲート絶縁膜が得られた。そして、この $P \cdot d$ 積が5以上の領域で成膜したゲート絶縁膜は、良好な電気特性を有しており、また、このゲート絶縁膜を窒素などの不活性ガス中でアニールすることによって、その電気特性をさらに向上させることができることが確認された。

【0014】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、この発明のゲート絶縁膜形成方法は、反応ガスとして有機シラン材料を用い、プラズマCVD法により成膜するものであり、これによって、段差部分の被覆性に優れ、ゲート電極と半導体層間のショートおよびゲート電極の断線が起きにくいゲート絶縁膜を低温で形成することができる。したがって、低融点の基板を用いる薄膜トランジスタの

ゲート絶縁膜の形成には特に有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明のゲート絶縁膜形成方法の実施に用いられるプラズマCVD装置を示す断面図である。

【図2】 従来の方法により形成されたゲート絶縁膜の成膜状態を示す薄膜トランジスタの部分断面図である。

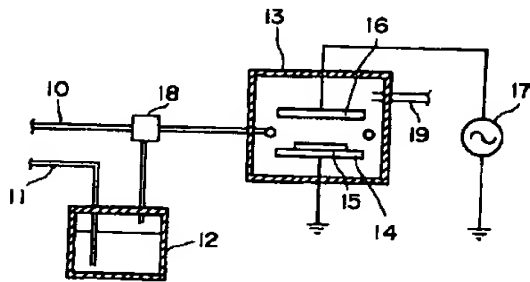
【図3】 この発明の方法により形成されたゲート絶縁膜の成膜状態を示す薄膜トランジスタの部分断面図である。

【図4】 成膜条件 $P \cdot d$ 積と成膜速度およびエッチングレートの関係を示すグラフである。

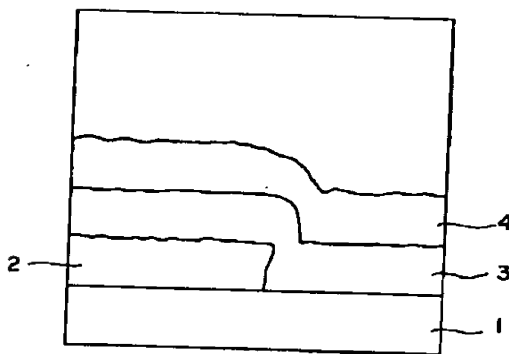
【符号の説明】

1…基板、2…半導体層、3…ゲート絶縁膜、4…ゲート電極、10…酸素導入口、11…バブリング用キャリアガス導入口、12…気化器、13…プラズマCVD装置チャンバ、14…試料台、16…カソード、17…高周波電源、18…反応ガス混合器、19…真空排気口

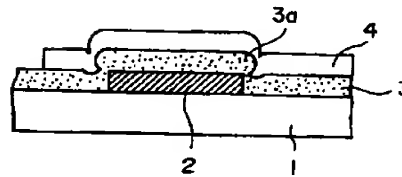
【図1】



【図3】



【図2】



【図4】

